

令和6年度第2回CRCフォーラム

真空成膜/表面技術

開催日時：令和7(2025)年1月27日(月)13:30-18:00

開催場所：東京電機大学 東京千住キャンパス 丹羽ホール（対面方式）

薄膜を作成する方法にはWetとDryの技術があります。メッキやスプレー、スピナー、ゾルゲル法等がWet技術に該当し、真空蒸着やイオンプレーティング、スパッタリング、CVD法等がDry技術となります。それぞれに特徴があり、表面の保護や表面の特性改善技術として色々な分野で活用されています。

今回のフォーラムでは、真空を用いた成膜技術を中心に、高い機能性を有する薄膜形成や表面処理や表面の解析評価等を、本分野で活躍している研究者の皆様に発表していただきます。

開会の挨拶 研究推進社会連携センター長 齋藤 博之

★基調講演（40分+質疑）

○ 真空技術による機能性薄膜創製と応用

工学部 電気電子工学科 教授 平栗 健二

★研究発表（発表時間は各30分+質疑）

○高周波プラズマを用いた薄膜作製と表面改質

工学部 情報通信工学科 教授 本橋 光也

<< 休憩 >>

○スパッタ技術を用いた化合物半導体単結晶層の成長とその評価

工学部 電子システム工学科 教授 篠田 宏之

○表面合金化による水素吸収速度の促進

工学部 自然科学系列 教授 小倉 正平

○細胞親和性を高めるDLC（diamond-like carbon）コーティング

理工学部 理工学科 電子情報・生体医工学系 教授 大越 康晴

○炭素材料を利用した水素ガスセンサーの開発

工学部 電気電子工学科 准教授 金杉 和弥

閉会の挨拶 研究推進社会連携センター 事務部長 堀 則子

お申込み

【日時】 令和7(2025)年1月27日(月) 13:30-18:00 予定

【場所】 東京電機大学 東京千住キャンパス 丹羽ホール（対面式のみ）

【定員】 先着200名（参加無料）

【詳細・申込】 Google forms

<https://forms.gle/vtgfEiv614opiQkW8>

※申し込み期限：2025年1月24日（金）正午

【お問い合わせ先】

東京電機大学 研究推進社会連携センター 研究推進担当 03-5284-5230

kenkyu-k@jim.dendai.ac.jp

